

半 导 体 学 报

第 12 卷 第 5 期 1991 年 5 月

目 录

- 电荷 DLTS 及其对硅上砷化镓材料中深能级的测量 董 琪 郑心畲 陈培毅 费新礪 (257)
Cr/GaAs 界面的反应特性及电子性质的研究 金高龙 陈维德 许振嘉 (265)
电场调制效应对氧化层电流弛豫谱的影响 许铭真 谭长华 刘晓卫 王阳元 (273)
硼磷硅玻璃在俄歇电子谱分析中的电子束和离子束辐照效应 陈维德 H. Bender (284)
用分子束外延在多孔硅衬底上外延单晶硅来实现 SOI 结构 周国良 盛 篓 樊永良 张翔九 俞鸣人 黄宜平 (289)
离化团束方法在 GaAs 衬底上外延 CdTe 单晶薄膜 冯嘉猷 汤海鹏 朱洪林 范玉殿 李恒德 (294)
- 研究简报**
- 半绝缘 InP 的铁能级研究 彭 承 孙恒慧 唐文国 李自元 (300)
用于宽带光纤用户网的高速 $1.3\mu\text{m}$ InGaAsP/InP DH LED 郭康瑾 肖德元 陈启玙 徐少华 陈瑞璋 张晓平 (304)
用于 $1.55\mu\text{m}$ InGaAsP/InP DFB 激光器的 $\lambda/4$ 相移衍射光栅 缪育博 张静媛 王 坊 (309)
亚微米 MOSFET 的计算机模拟 张义门 滕建旭 (313)
- 研究快报**
- GaAs/AlAs 超晶格中的纵光学声子模的近共振散射研究 汪兆平 韩和相 李国华 江德生 Klaus Ploog (317)